

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-196494

(43) 公開日 平成6年(1994)7月15日

(51) Int.Cl.

識別記号

序内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 1 L 21/336

23/784

9054-4M

H 0 1 L 29/78

3 0 1 L

9054-4M

3 0 1 P

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 1 頁)

(21) 出願番号 特願平4-342488

(71) 出願人 000001258

川崎製鉄株式会社

(22) 出願日 平成4年(1992)12月22日

兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

(72) 発明者 中村 謙二

東京都千代田区幸町2丁目2番3号 川崎製鉄株式会社東京本社内

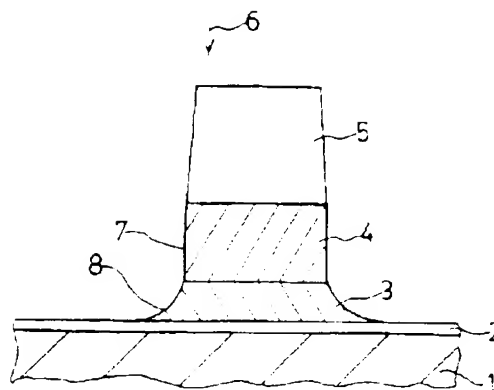
(74) 代理人 弁理士 小杉 佳男 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 LEDトランジスタ構造のゲート電極形成を1回のイオン注入によって実施でき、優れたLED構造を得る。

【構成】 ゲート電極形成において、基板1、ゲートSiC、膜2上に最初にポリシリコン3を成膜し、その上にアモルファスシリコン4を成膜し、フォトリソ5を載せて、このシリコン膜をソンドープのままドライエッチング6を行う。アモルファスシリコン4の側面7は垂直になり、ポリシリコン3の側面8はテーパ状となる。次にイオン注入すれば優れたLED構造のゲート電極が形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 上記のトランジスタ構造の形成において、最初にポリシリコンを成膜し、引き続きアモルファスシリコンを成膜し、このシリコン膜をノンドープのままドライエッチングし、ゲート電極を形成した後、ゲート及びソース、ドレイン領域に同時に不純物イオン注入を行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明はLDDトランジスタ構造 10を有する半導体装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 LDD (Lightly doped drain: 低濃度ドープドレイン) トランジスタは、一般に次の工程によって作成されている。

(1) ゲート電極を形成する。  
(2) イオン注入により低濃度の、浅いソース・ドレイン領域を形成する。  
(3) CVDによって酸化膜を形成する。  
(4) 異方性エッチングを行い、ゲート電極側壁にサイドウォールを形成する。このサイドウォールにより、次の工程でイオン注入された領域の横方向拡散の先端部はポリシリコンの位置とサイドウォールの端によって決まる。

(5) イオン注入によって高濃度のソース・ドレイン領域を形成する。このとき、ゲートは高濃度にドープされたソース・ドレイン領域とオーバーラップせず、ドレイン領域の境界面における低い不純物濃配を実現することができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 上記従来技術ではイオン注入工程が2回となるほか、サイドウォール形成工程などプロセスが複雑でコストがかかる。またサイドウォール形成の際のSiO<sub>2</sub>のエッチングによってSi基板の割れ込みが生じ、これが欠陥層のもとになり、接合リークが発生するという問題があった。

【0004】 本発明はこのような問題点を解決し、簡易に、優れたLDDトランジスタを形成する方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明は、ゲート電極材料の下層をポリシリコン、上層をアモルファスシリコンとし、ノンドープのまま異方性エッチングを行うことによって、上層のアモルファスシリコン層の側壁は垂直に、下層のポリシリコン層の側壁はテーパー形状にエッチングされることを利用している。この際、エッチング条件はポリシリコン層に垂直にエッチングできる条件の工程のみであり、

【0006】 次にソース・ドレイン領域形成のためNチ

オド側にはP<sup>+</sup>あるいはAs<sup>+</sup>を、Pチャネル側にはB<sup>+</sup>あるいはB<sup>+</sup>をイオン注入する。これによりソース・ドレインも成と同時にゲート電極にも高濃度に不純物を注入することができ、また、ゲート電極のポリシリコン層がテーパー形状となっているため、このソース・ドレインへの高濃度イオン注入を1回だけ行うことによって、LDD構造を形成することが可能となる。

【0007】

【作用】 従来方法では、(1) ゲートポリシリコン成膜、(2) 不純物注入及びアニール、(3) ゲート加工、(4) 低濃度イオン注入、(5) サイドウォール形成、(6) 高濃度イオン注入という工程必要であったが、本発明方法によれば、(a) ゲート(ポリ/アモルファス)シリコン成膜、(b) ゲート加工、(c) 高濃度イオン注入、(d) ゲートエッチング(等方エッチ)と4工程に省略することができる。

【0008】 ポリシリコン成膜とアモルファスシリコン成膜は成膜CVD装置により、成膜温度を600℃以上、570℃以下にそれぞれ設定し、成膜途中で変更することにより同一工程において成膜することができる。また、サイドウォール形成におけるSiO<sub>2</sub>のエッチングを省略することができるので、基板の割れ込みが生じない。従って、接合リーク欠陥を防ぐことができる。

【0009】

【実施例】 ゲート酸化膜上に、減圧CVD装置で、ポリシリコン及びアモルファスシリコン膜を成膜する。このシーケンスを図7に示した。ポリシリコン膜を620℃で1500Å成膜し、ポリシリコン成膜後、炉の温度を550℃に下げることによって、アモルファスシリコンを成膜する。アモルファスシリコンの膜厚は3000Åとする。図1にこれを示すもので、シリコン基板1、ゲートSiO<sub>2</sub>膜2の上に620℃でポリシリコン3を1500Å、その上にアモルファスシリコン4を3000Å形成し、フォトリソレジスト5を載せたものである。

【0010】 次にRIE装置で次の条件によりゲートエッチングする。

使用ガス : O<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>, He, CF<sub>4</sub>  
= (90~100) × 3.50 × 20 (sccm)  
圧力 : 2.90~3.60 (mTorr)  
RFパワー : 120~150 W  
電極温度 : 45~55℃

図2に示すように、異方性エッチングを受けたアモルファスシリコン1の側面は垂直に、ポリシリコン3の側面はテーパー状となり、図3に示すようにポリシリコン3のテーパー形状は高さは0.15μm程度である。

【0011】 次に図4に示すように基板内領域内にイオン注入を行う。Nチャネル側にはAs<sup>+</sup>を1.0×10<sup>15</sup> cm<sup>-2</sup>でイオン注入し、Pチャネル側にはB<sup>+</sup>を1.0×10<sup>15</sup> cm<sup>-2</sup>でイオン

3

注入する。ゲート電極12にも高濃度に $\text{N}^+$ 種を注入を行うことができ、図5に示すようにN+チャンネル側ではN+ソース・ドレイン11、N+ソース・ドレイン11が形成される。

【0012】最後に図5に示すようにゲートシリコン膜12をケミカルドライエッチにより等方エッチングし、ゲート下部の長さをソース・ドレインの低濃度側に合うようにする。エッチング部13のエッチング量は100 $\mu\text{m}$ である。このようにして形成されたトランジスタは、従来のサイドウォール長0.15 $\mu\text{m}$ のLDDトランジスタと同等の性能をもっている。

【0013】

【発明の効果】本発明によれば、下層にはポリシリコン層、上層にはアモルファスシリコン層を形成し、これをノンドライのままでドライエッチングすることによってアモルファス層の側面は鉛直に、ポリシリコン層の側面はテーパ状となる。従って、1回のイオン注入によって、優れたLDD構造をもドレイン領域を形成することが可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】レジスト形成時の断面図である。

【図2】異方性エッチング工程の説明図である。

【図3】異方性エッチング工程終了時の説明図である。

【図4】イオン注入工程の説明図である。

【図5】焼鈍後の断面図である。

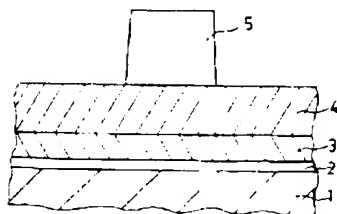
【図6】シリコンエッチング工程の断面図である。

【図7】シリコン成膜時の温度パターン図である。

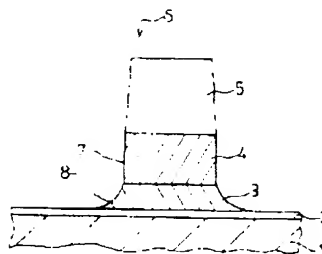
【符号の説明】

1	S:基板	2	ゲートSi
2	膜		
3	ポリシリコン	4	アモルファスシリコン
5	フォトレジスト	6	エッチング
7, 8	側面	9	領域
10	N+ソース・ドレイン	11	N+ソース・ドレイン
12	ゲートシリコン膜	13	エッチング部

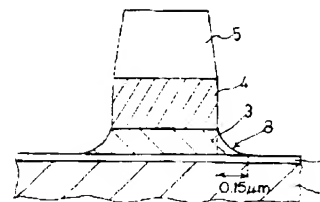
【図1】



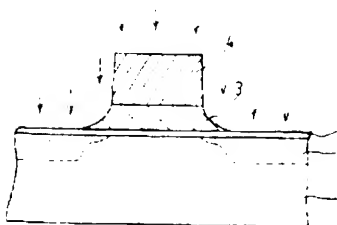
【図2】



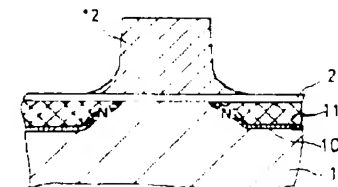
【図3】



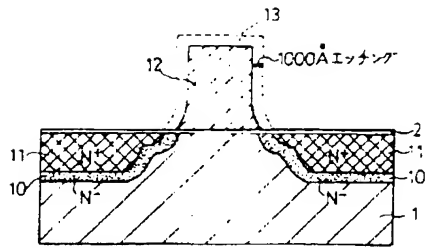
【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

